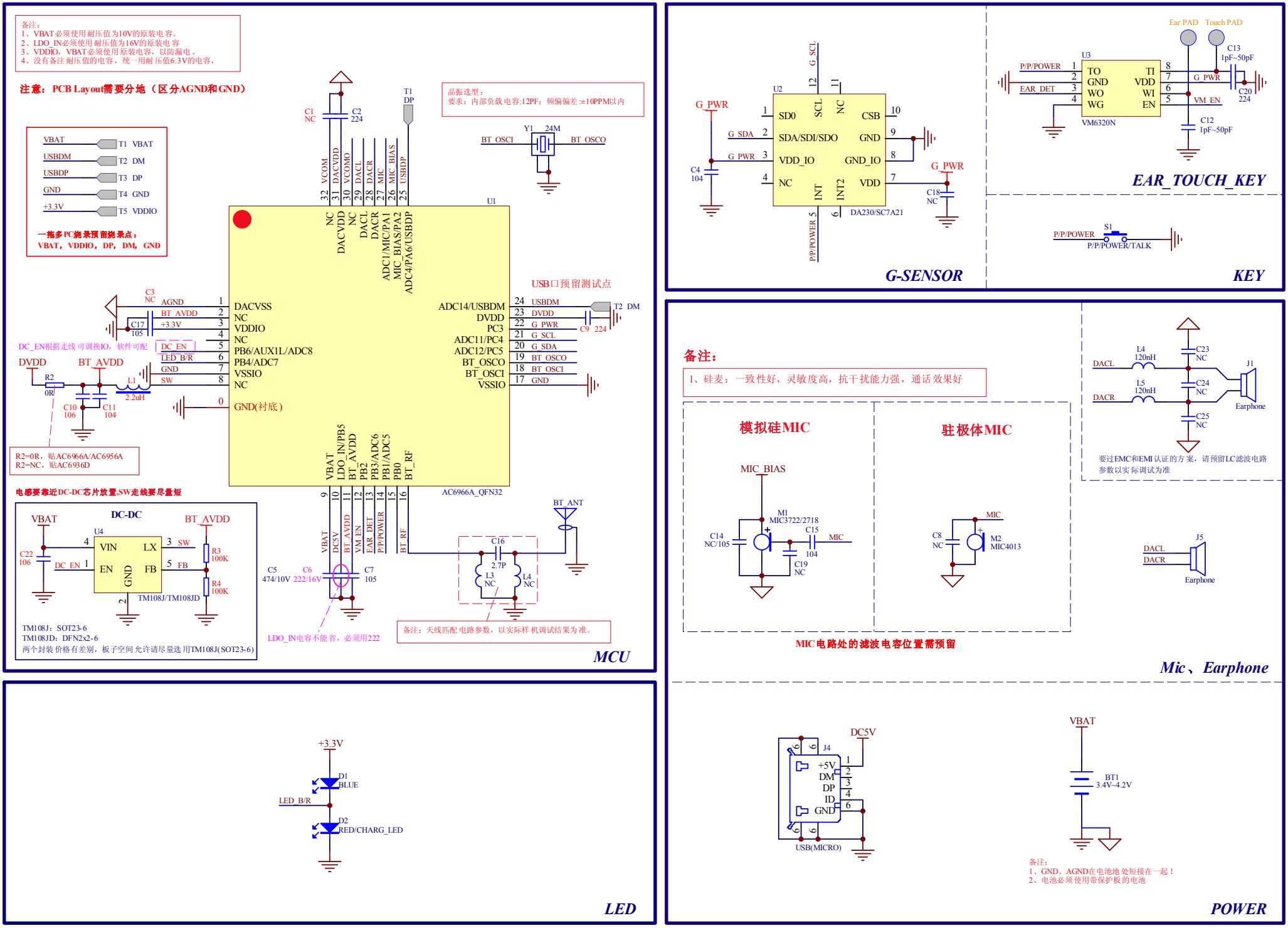

备注：
1、VBAT必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、LDO_IN必须使用耐压值为16V的原装电容
3、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
4、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
U1
DACVSS
NC
VDDIO
NC
PB6/AUX1L/ADC8
PB4/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
ADC14/USBDM
DVDD
PC3
ADC11/PC4
ADC12/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
USB口预留测试点
T2 DM
AC6966A_QFN32
DC_EN根据走线 可调换IO，软件可配
R2=0R，贴AC6966A/AC6956A
R2=NC，贴AC6936D
电感要靠近DC-DC芯片放置,SW走线要尽量短
DC-DC
U4
VIN
LX
EN
GND
FB
TM108J/TM108JD
TM108J：SOT23-6
TM108JD：DFN2x2-6
两个封装 价格有差别，板子空间 允许请尽量选 用TM108J(SOT23-6)
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配 电路参数，以实际样 机调试结果为准。
MCU
U2
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
SCL
NC
CSB
GND
GND_IO
INT
INT2
VDD
DA230/SC7A21
G_PWR
G_SDA
G_SCL
P/P/POWER
G-SENSOR
Ear PAD
Touch PAD
U3
TO
GND
WO
WG
TI
VDD
WI
EN
VM6320N
P/P/POWER
EAR_DET
G_PWR
VM_EN
EAR_TOUCH_KEY
S1
P/P/POWER/TALK
KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1
MIC3722/2718
驻极体MIC
M2
MIC4013
MIC
MIC电路处的滤波电容位置需预留
L4
120nH
L5
120nH
DACL
DACR
J1
Earphone
要过EMC和EMI认证的方 案，请预留LC滤波电路
参数以实 际调试为准
J5
Mic、Earphone
+3.3V
D1
BLUE
D2
RED/CHARG_LED
LED_B/R
LED
DC5V
J4
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须 使用带保护板的电池
POWER